

# 次世代メモリー技術の実用化に向けた取り組みが NEDO の研究開発助成事業に採択

～早期実用化に向けた研究開発の加速を目的に、資金調達を実施～

ソフトバンク株式会社の子会社である SAIMEMORY 株式会社(サイメモリ、本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:山口秀哉、以下「SAIMEMORY」)は、インテル株式会社(以下「インテル」)と共同で推進する次世代メモリー技術の研究開発プロジェクト「高密度・広帯域・低消費電力 ZAM(Z-Angle Memory)の開発(以下「本プロジェクト」)」が、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「ポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業/先端半導体製造技術の開発(助成)」の研究開発テーマである「高メモリー密度・広帯域・低消費電力な革新的メモリーの製造技術開発」に採択されましたのでお知らせします※1。

本プロジェクトでは、SAIMEMORY を代表事業者として、インテルを共同実施者、国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」)を共同研究先とする体制の下、日本発の次世代メモリー技術である ZAM の実用化に向けた研究開発を推進します。その中核技術として、配線を使用せずに磁界で接続する「磁界結合無線通信 I/O」を備えた「垂直ビルド(Z-Angle)」構造を世界で初めて※2 採用することで放熱性能を向上させ、現行のメモリー技術が抱える積層数による制約の解決に取り組めます。これにより、メモリーの容量拡大、データ転送帯域幅の向上、および低消費電力化を同時に実現し、AI 計算基盤のさらなる高度化に貢献します。

また SAIMEMORY は、次世代メモリー技術の早期実用化に向けた研究開発の加速を目的として、富士通株式会社、株式会社日本政策投資銀行、理研およびソフトバンク株式会社を引受先として、シリーズ A ラウンドの資金調達を実施しました。SAIMEMORY は、この資金を生かして、ZAM の商用化およびメモリーメーカーなどへの技術ライセンスの提供を見据え、研究開発を推進していきます。

SAIMEMORY の代表取締役社長 兼 CEO である 山口秀哉は、次のように述べています。「本プロジェクトが NEDO 事業に採択されたことは、日本発の次世代メモリー技術を世界に示す重要な一歩であると受け止めています。次世代メモリー技術『ZAM』は、AI 時代に求められる性能と電力効率の両立を実現する革新的なアーキテクチャーです。本プロジェクトを共に推進するインテルや理研、資金面でご支援いただく皆さまをはじめとする国内外のパートナーとの連携によって、日本の半導体産業の国際競争力強化に貢献していきます」

---

※1 実施内容・採択テーマについての詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。

[https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3\\_100361.html](https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100361.html)

※2 当社調べ。2026 年 4 月 22 日時点。